New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

20 STERN AVE.
SPRINGFIELD, NEW JERSEY 07081
U.S.A.

TELEPHONE: (973) 376-2922
(212) 227-6005
FAX: (973) 376-8960

2SD633
2SD634
2SD635

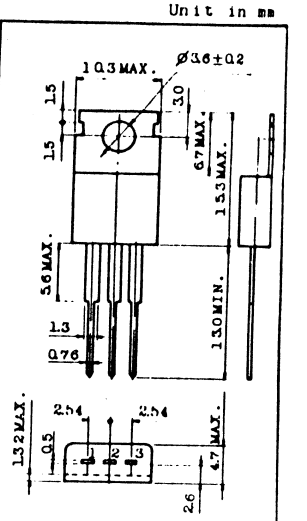
シリコンNPN三重拡散メサ形ダーリントントラ
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA DARLINGTO
TRANSISTOR

○ 大電力スイッチング
○ ハンマードライブ，モータードライブ

- Power Switching Applications
- Hammer Drive, Pulse Motor Drive Applications
- High DC Current Gain
  h_{FE} = 2000 (Min.) (V_{CE} = 3V, I_C = 3A)
- Low Collector Emitter Saturation Voltage
  $V_{CE(sat)}$ = 1.5V (Max.), (I_C = 3A)
- Monolithic Construction with Built-In Base-Emitter shunt Resistor

通 信 工 業 用
INDUSTRIAL APPLICATIONS

Unit in mm



JEDEC	TO-220AB
EIAJ	SC-46

アクセサリはAC75を適用
MOUNTING KIT NO. AC75

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta = 25℃)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	2SD633	V_{CBO}	100	V
	2SD634		80	
	2SD635		60	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SD633	V_{CEO}	100	V
	2SD634		80	
	2SD635		60	
エミッタ・ベース間電圧		V_{EBO}	5	V
コレクタ電流		I_C	7	A
ベース電流		I_B	0.2	A
コレクタ損失 (Tc = 25℃)		P_C	40	W
接合温度		T_j	150	℃
保存温度		T_{stg}	-55～150	℃

NJ Semi-Conductors reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by NJ Semi-Conductors is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However NJ Semi-Conductors assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. NJ Semi-Conductors encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25℃)

CHARACTERISTIC		SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしゃ断電流	2SD633	I_{CBO}	V_{CB}= 100V , I_E = 0	—	—	100	μA
	2SD634		V_{CB}= 80V , I_E = 0	—	—	100	
	2SD635		V_{CB}= 60V , I_E = 0	—	—	100	
エミッタしゃ断電流		I_{EBO}	V_{EB}= 5V , I_C=0	—	—	3.0	mA
コレクタ・エミッタ間 降伏電圧	2SD633	$V_{(BR)CEO}$	I_C= 50mA , I_B=0	100	—	—	V
	2SD634			80	—	—	
	2SD635			60	—	—	
直流電流増幅率 (Note)		$h_{FE(1)}$	V_{CE} = 3V , I_C = 3A	2000	—	15000	
		$h_{FE(2)}$	V_{CE} = 3V , I_C = 7A	1000	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 (Note)		$V_{CE(sat)(1)}$	I_C = 3A , I_B = 6mA	—	0.9	1.5	V
		$V_{CE(sat)(2)}$	I_C = 7A , I_B = 14mA	—	1.2	2.0	
ベース・エミッタ間飽和電圧(Note		$V_{BE(sat)}$	I_C = 3A , I_B = 6mA	—	1.5	2.5	V
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	(Fig. 2)	—	0.8	—	μs
	蓄積時間	t_{stg}		—	3.0	—	
	下降時間	t_f		—	2.5	—	

Note : Pulse Test ; Pulse width ≦ 300μs, Duty cycle ≦ 2%